14000–18000 MHz GaN MMIC パワーアンプ・ベアダイ

LCI-PA-14000-18000-PS45T は 14000–18000 MHz をカバーする GaN MMIC パワーアンプのベアダイです。パルス動作に対応します。

パルス動作: PSAT: 45 dBm (標準値); 電力利得: 24 dB (標準値); PAE: 41 % (標準値).
ダイ寸法: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.



RF 特性 TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; パルス動作

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	14000	-	18000	MHz
飽和出力電力	Psat	-	45	-	dBm
電力利得	Gp	-	24	-	dB
電力利得平坦度	ΔGp	-	±0.3	-	dB
電力付加効率	PAE	-	41	-	%
入力 VSWR	VSWR(in)	-	-	2	-

DC バイアスと電流 TA = +25 °C

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
ドレイン電圧	Vd	24	28	32	V
ゲート電圧	Vg	-2.4	-2.2	-1.8	V
ドレイン静止電流	Id	-	0.3	-	A
ドレイン動作電流	Idd	-	2.7	-	A
ゲート動作電流	Igg	-	0.5	5	mA

絶対限界値

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	Vd	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	Vg	-5	-	-	V
最大入力電力	Pin	-	-	24	dBm
保存温度	TSTG	-65	-	150	°C
最大チャネル温度	Top	-	-	225	°C

ダイ寸法

項目	値	単位
ダイ寸法	3.1 × 2.45 × 0.08	mm

現在の発行記録 · 1.6 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.5.

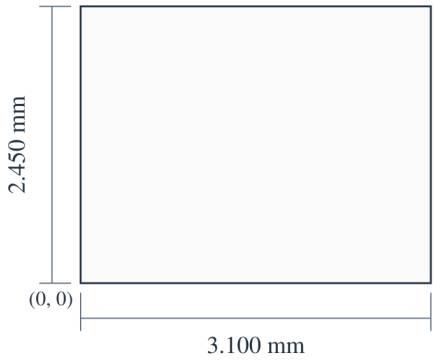
ダイ実装とバイアスの印加順序

内蔵 DC ブロック: RFin / RFout. 接地への DC 経路: RFin → GND. 別条件での特性評価: Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; τ = 100 µs; D = 10%. ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 両側からのバイアス給電を推奨します。

外形寸法図

外形および寸法が示された座標の参照図です。寸法の単位は mm です。製造およびワイヤボンディングには、それぞれの詳細図面が必要です。

LCI-PA-14000-18000-PS45T



X (mm)
Vg: 0.130
Vd1: 0.660
Vd2: 1.180
Vd3: 2.810

Y (mm)
RFin / RFout: 1.225

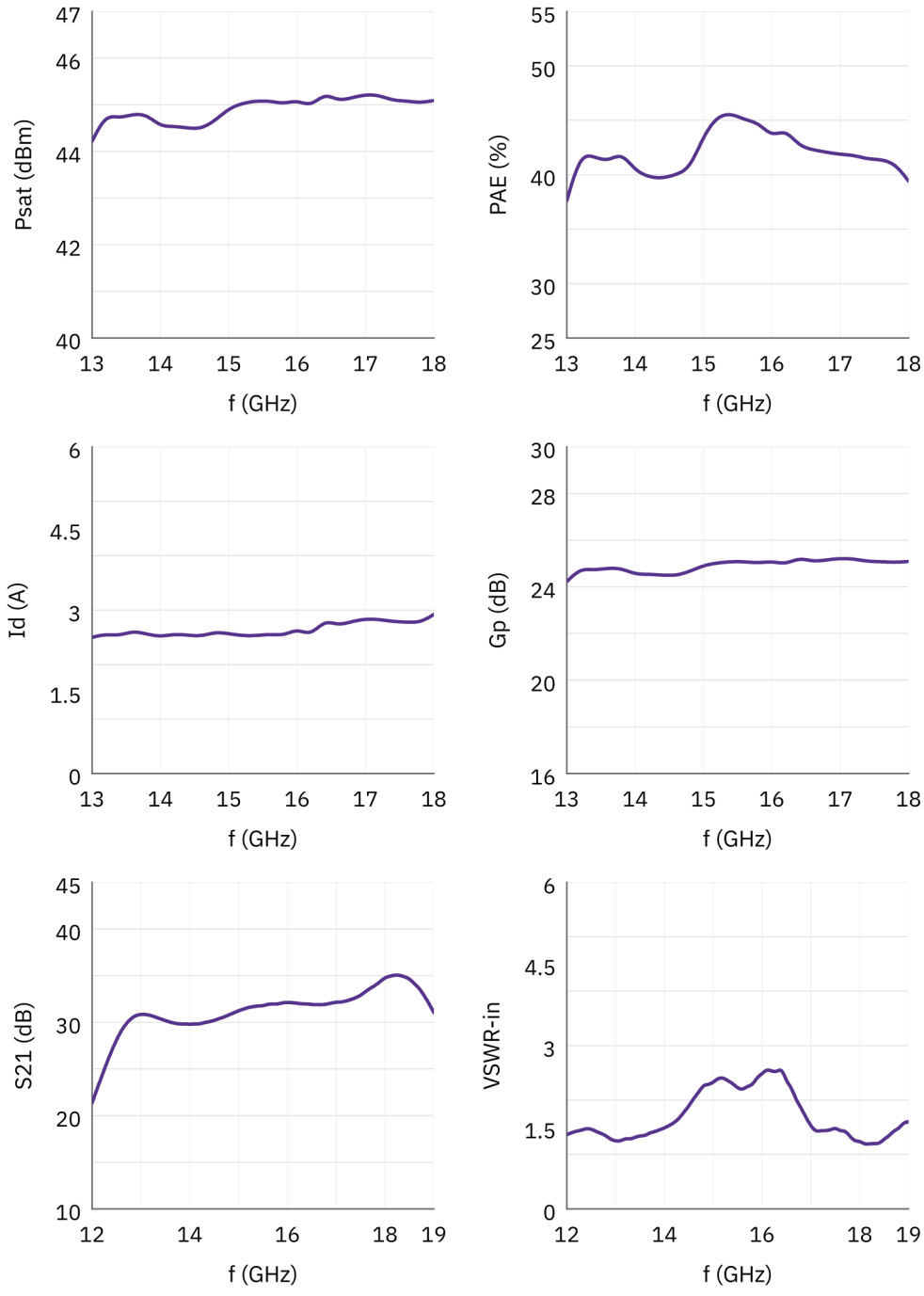
3.100 × 2.450 × 0.080 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

性能特性曲線

各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。

飽和出力電力、電力付加効率、ドレイン動作電流、電力利得、小信号利得、入力整合。

図の注記：Vd=+28V; Vg=-2.2V。 飽和出力電力、PAE、動的ドレイン電流、電力利得：Pin = 20 dBm。小信号利得、入力VSWR：Pin = -20 dBm。 読み取り値は近似値です。



文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。